

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成16年12月9日(2004.12.9)

【公開番号】特開2000-208780(P2000-208780A)

【公開日】平成12年7月28日(2000.7.28)

【出願番号】特願2000-35989(P2000-35989)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 29/786

G 02 F 1/1368

H 01 L 21/336

【F I】

H 01 L 29/78 6 1 3 A

G 02 F 1/136 5 0 0

H 01 L 29/78 6 1 8 Z

【手続補正書】

【提出日】平成15年12月22日(2003.12.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0051】

図5には、同一基板上に形成されるNチャネル型TFTの90%が180(cm<sup>2</sup>/Vs)を超える260(cm<sup>2</sup>/Vs)以下の移動度を有していることが示されている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0052

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0052】

図6には、得られるPチャネル型TFTの90%が110(cm<sup>2</sup>/Vs)を超える150(cm<sup>2</sup>/Vs)以下の移動度を有していることが示されている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0053

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0053】

上記のことは、任意に100個のTFTを選びだした場合、平均してその90個が上述したような移動度を示すことを意味している。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

【課題を解決するための手段】

本明細書で開示する発明の一つは、

絶縁表面上に形成された薄膜トランジスタでなるオペアンプ回路群であって、前記オペアンプ回路は、少なくともNチャネル型の薄膜トランジスタとPチャネル型の薄膜トランジスタを組み合わせて構成されており、前記Nチャネル型の薄膜トランジスタの90%はその移動度が $180\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ を超える $260\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ 以下の値を有し、前記Pチャネル型の薄膜トランジスタの90%はその移動度が $110\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ を超える $150\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ 以下の値を有していることを特徴とする。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

Nチャネル型の薄膜トランジスタとPチャネル型の薄膜トランジスタが組み合わされて構成されたオペアンプ回路群であって、

前記Nチャネル型の薄膜トランジスタと前記Pチャネル型の薄膜トランジスタは同一基板上に形成されており、

前記Nチャネル型の薄膜トランジスタのうち90%は、移動度が $180\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ を超える $260\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ 以下の値を有し、

前記Pチャネル型の薄膜トランジスタのうち90%は、移動度が $110\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ を超える $150\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ 以下の値を有することを特徴とするオペアンプ回路群。

【請求項2】

Nチャネル型の薄膜トランジスタとPチャネル型の薄膜トランジスタが組み合わされて構成された差動増幅回路群であって、

前記Nチャネル型の薄膜トランジスタと前記Pチャネル型の薄膜トランジスタは同一基板上に形成されており、

前記Nチャネル型の薄膜トランジスタのうち90%は、移動度が $180\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ を超える $260\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ 以下の値を有し、

前記Pチャネル型の薄膜トランジスタのうち90%は、移動度が $110\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ を超える $150\text{ (cm}^2/\text{Vs)}$ 以下の値を有することを特徴とする差動増幅回路群。